

СОДЕРЖАНИЕ

Технологические процессы и маршруты

<i>Афанасьев А.В., Ильин В.А., Лучинин В.В., Решанов С.А.</i> Анализ эпитаксии карбида кремния из газовой фазы как базового процесса в технологии силовой электроники. Обзор.....	483
<i>Силаев И.В., Гончаров И.Н., Магкоев Т.Т., Радченко Т.И.</i> Метод и реализация высокоэффективной диагностики формы электронного зонда растрового электронного микроскопа.....	497
<i>Воробьев А.В., Жора В.Д., Плис Н.И., Тимошенков С.П.</i> Исследование влияния технологических факторов на характеристики гибких безадгезивных фольгированных диэлектриков.....	505

Элементы интегральной электроники

<i>Елисеева Д.А., Сафонов С.О.</i> Анализ механизмов деградации подзатворных диэлектриков на основе SiO ₂ в МОП-транзисторах.....	517
--	-----

Схемотехника и проектирование

<i>Заплетина М.А., Жуков Д.В., Гаврилов С.В.</i> Методы анализа выполнимости булевых формул для современных задач систем автоматизации проектирования в микроэлектронике	525
--	-----

Микро- и наносистемная техника

<i>Амеличев В.В., Генералов С.С., Николаева А.В., Поломошнов С.А., Ковалев В.А., Ковалев А.М., Кривецкий В.В.</i> Исследование чувствительности пористых толсто пленочных элементов на основе SnO ₂ к концентрации водорода в воздухе	539
--	-----

Информационно-коммуникационные технологии

<i>Гаращенко А.В., Газарина Л.Г.</i> Методика формирования тестовых последовательностей на основе графовой модели иерархии кеш-памяти.....	548
--	-----

Краткие сообщения

<i>Чаплыгин Ю.А., Лосев В.В., Калёнов А.Д.</i> Метод проектирования широкополосного формирователя квадратурных сигналов.....	558
<i>Урумов В.В.</i> Влияние внешнего излучения на емкостные и токовые характеристики излучающих структур.....	563
<i>Крылов В.П., Богачев А.М.</i> Релаксация глубоких центров в транзисторах и интегральных микросхемах	568

Тематический указатель статей, опубликованных в 2020 году	573
---	-----